

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

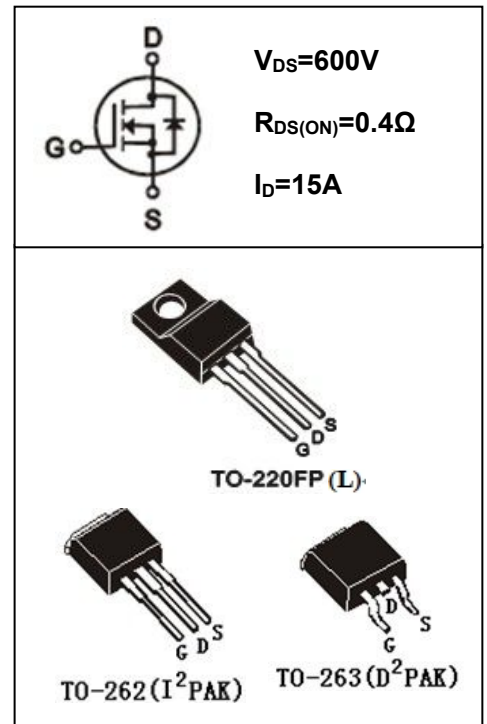
SIF15N60C

- 特点：热阻低 开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范
- FEATURES: ■LOW THERMAL RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE
■RoHS COMPLIANT
- 应用：电子镇流器 电子变压器 开关电源
- APPLICATION: ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ■SWITCH MODE POWER SUPPLY

●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) **TO-220FP(L)/262/263**

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V _{DS}	600	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V _{GS}	±30	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I _D	15*	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I _D	9.6*	A
最大脉冲电流 Drain Current - Pulsed ①	I _{DM}	60*	A
耗散功率 Power Dissipation	P _D	220FP:65 262/263:225	W
最高结温 Junction Temperature	T _J	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{STG}	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy	E _{AS}	900	mJ



*漏极电流由最高结温限制

*Drain current limited by maximum junction temperature

●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	600			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	ΔBV _{DSS} / ΔT _J	I _D =250uA, Referenced to 25°C		0.6		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	3.0		5.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I _{DSS}	V _{DS} =600V, V _{GS} =0V, T _J =25°C			1	μA
		V _{DS} =480V, V _{GS} =0V, T _J =125°C			10	μA
跨导 Forward Transconductance	g _{fs}	V _{DS} =40V, I _D =7.5A ③		8		S
二极管电压变动率 Reverse Diode dv/dt	dv/dt	I _{SD} ≤16A, T _J =25°C		10		V/ns

●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
TO-220FP(L) 条管装/TUBE PACKING	SIF15N60C TO-220FP(L) -TU	SIF15N60C TO-220FP(L) -TU-HF
TO-262 或 263 条管装/TUBE PACKING	SIF15N60C TO-262-TU 或 SIF15N60C TO-263-TU	SIF15N60C TO-262-TU-HF 或 SIF15N60C TO-263-TU-HF
TO-263 编带装/TAPE & REEL PACKING	SIF15N60C TO-263-TR	SIF15N60C TO-263-TR-HF

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF15N60C

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 7.5A$ ③		0.40	0.50	Ω
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		2100		pF
输出电容 Output Capacitance	C_{oss}			190		
反向传输电容 Reverse transfer Capacitance	C_{rss}			33		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_d(off)$	$V_{DD} = 300V, I_D = 16.0A$ $R_G = 25\Omega$ ③		110		ns
开启延迟时间 Turn-on delay time	$T_d(on)$			70		
开启上升时间 Rise time	T_r			190		
关断下降时间 Fall time	T_f			100		
栅极电荷 Total Gate Charge	Q_g	$I_D = 16.0A, V_{DS} = 400V$ $V_{GS} = 10V$ ③		47		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			11		
栅极开启电荷量 Gate charge at threshold	$Q_{g(th)}$			3.1		
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			18		
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_s				15.0	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j = 25^\circ C, I_s = 15.0A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_j = 25^\circ C, I_f = 15.0A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		550		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			5.5		μC
输入阻抗 Gate resistance	R_G				7	Ω

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX		单位 UNIT
		TO-220FP(L)	TO-262/263	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	R_{thJC}	1.92	0.56	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	R_{thJA}	62.5	62.5	$^\circ C/W$

注释(Notes):

- ① 脉冲宽度：以最高节温为限制
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
- ② Starting $T_j = 25^\circ C, V_{DD} = 50V, L = 5mH, R_G = 25\Omega, I_{AS} = 15A$
- ③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$
Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF15N60C

● 特性曲线

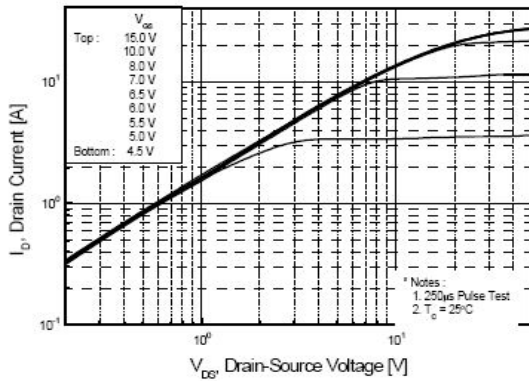


图 1 输出特性曲线, Tc=25°C
Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25°C

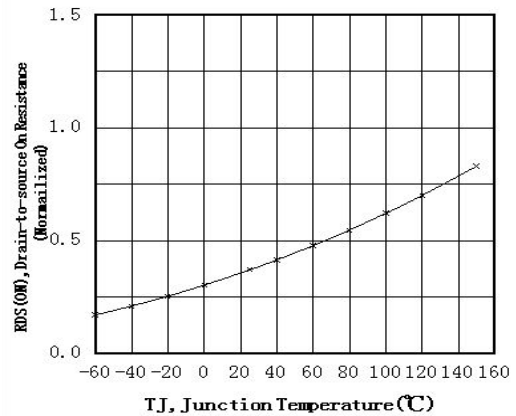


图 2 导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线
Fig2 On-Resistance Vs.Drain Current and Gate Voltage

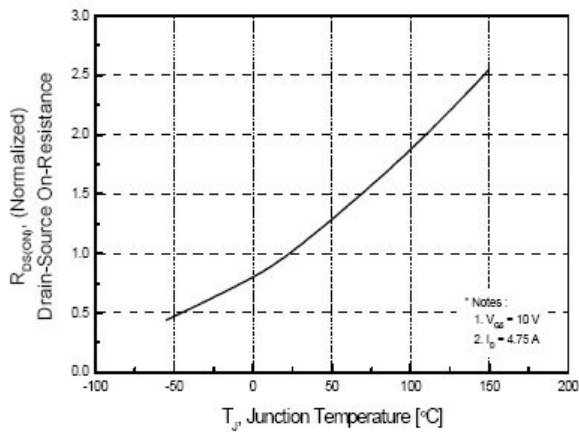


图 3 导通电阻与温度曲线
Fig3 Normalized On-Resistance Vs. Temperature

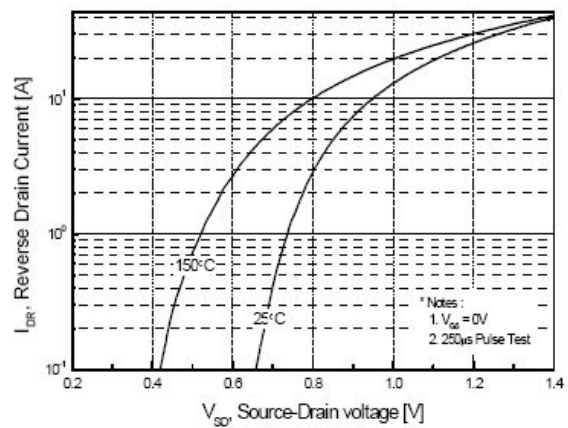


图 4 二极管正向电压曲线
Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

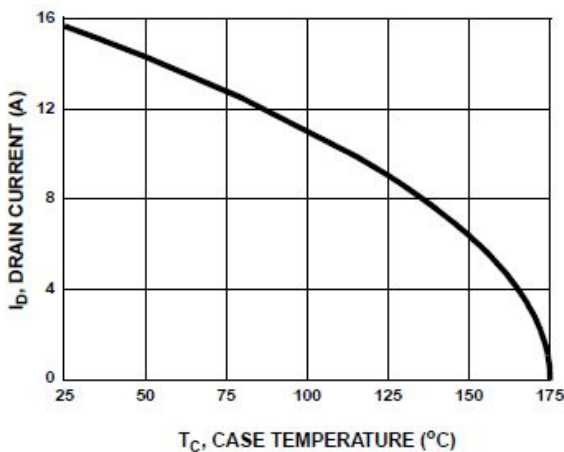


图 5 最大漏极电流与壳温曲线
Fig5 Maximum Drain Current Vs.Case Temperature

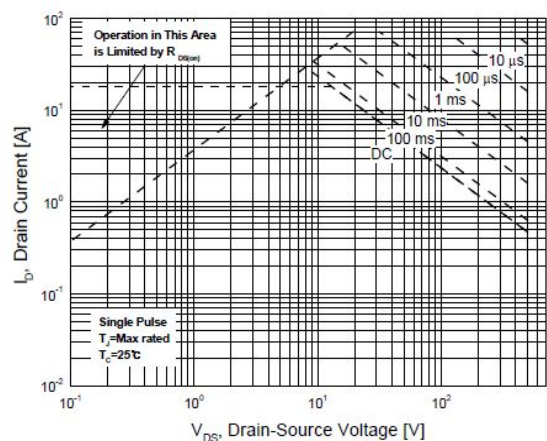
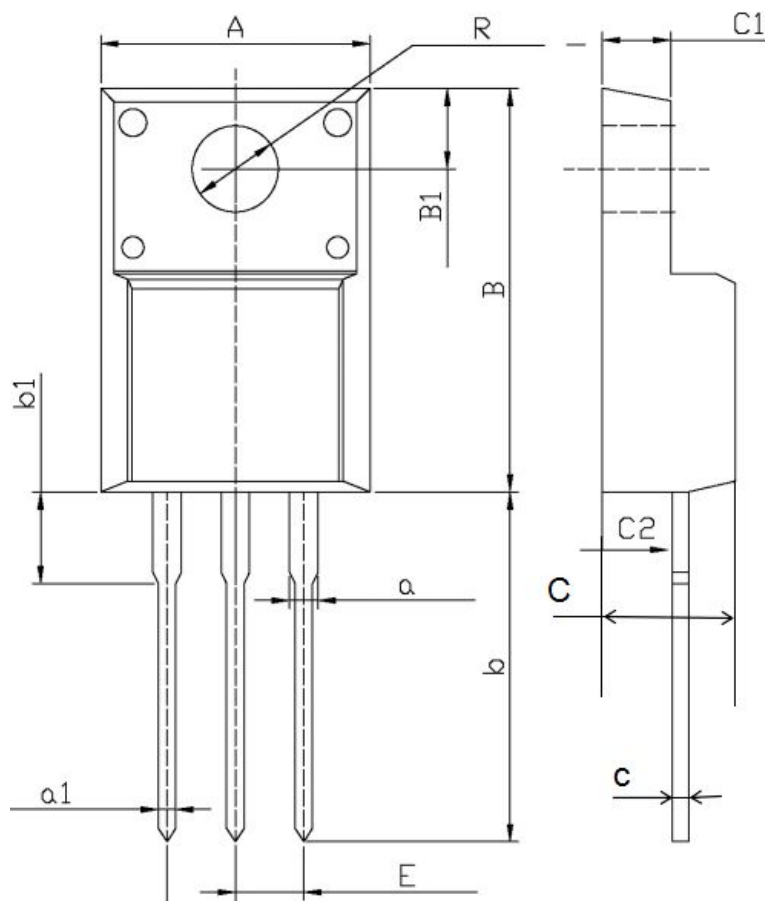


图 6 最大安全工作区曲线
Fig6 Maximum Safe Operating Area

TO-220FPL 封装机械尺寸 TO-220FPL MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

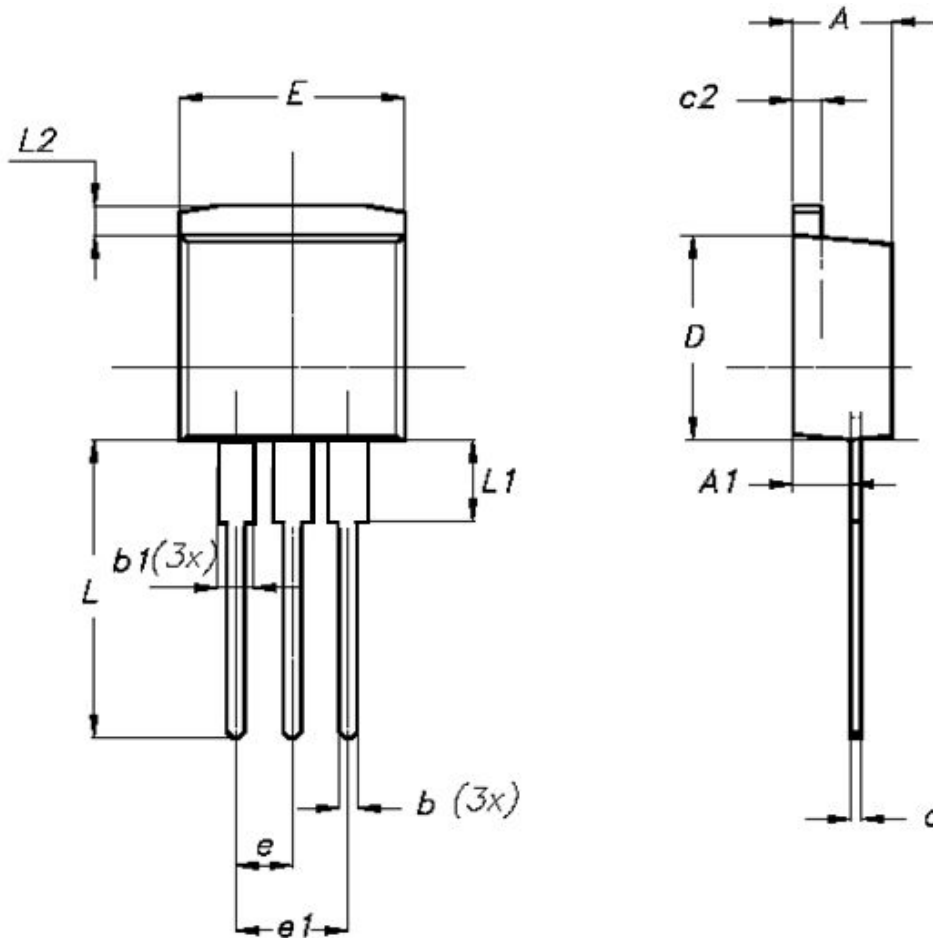
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	9.90		10.36	a	1.08		1.48
B	15.40		16.40	a1	0.70		0.90
B1	3.05		3.55	E	2.34		2.75
C	4.40		5.00	C1	2.25		2.85
c	0.40		0.60	C2	2.45		3.05
b	12.40		13.50	R	2.90		3.35
b1	2.90		3.90				Ⓛ



TO-262 封装机械尺寸 TO-262 MECHANICAL DATA

单位：毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	3.80		4.80	e		2.54	
A1	2.00		2.80	e1			5.30
b	0.60		1.00	E	9.90		10.70
b1	1.20		1.40	L	12.50		14.50
c	0.40		0.70	L1	0.80	1.00	1.20
c2	1.10		1.40	L2			1.50
D			9.60				

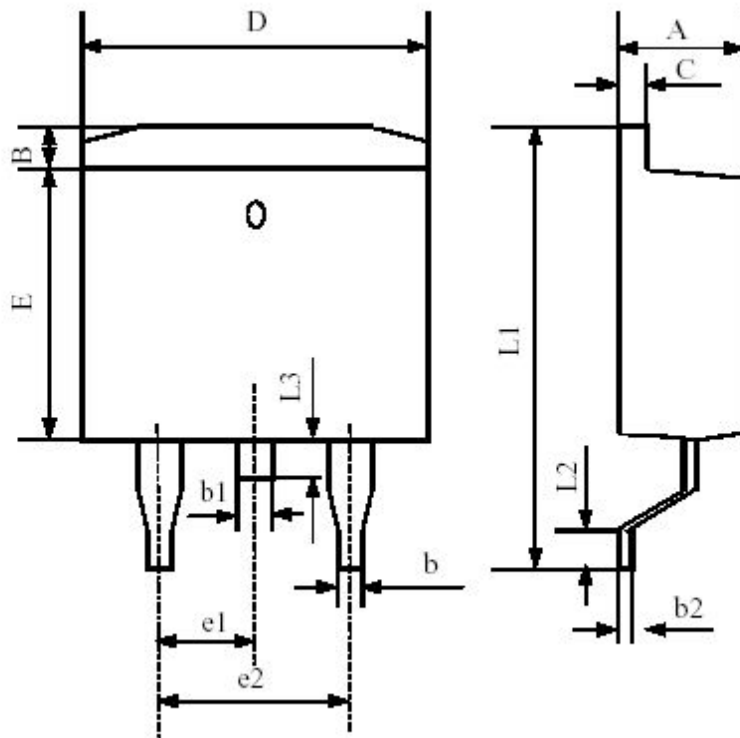


TO-263 封装机械尺寸

TO-263(D2PAK) MECHANICAL DATA

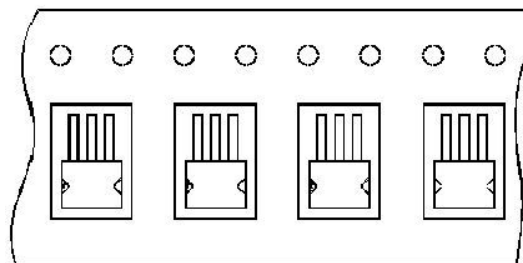
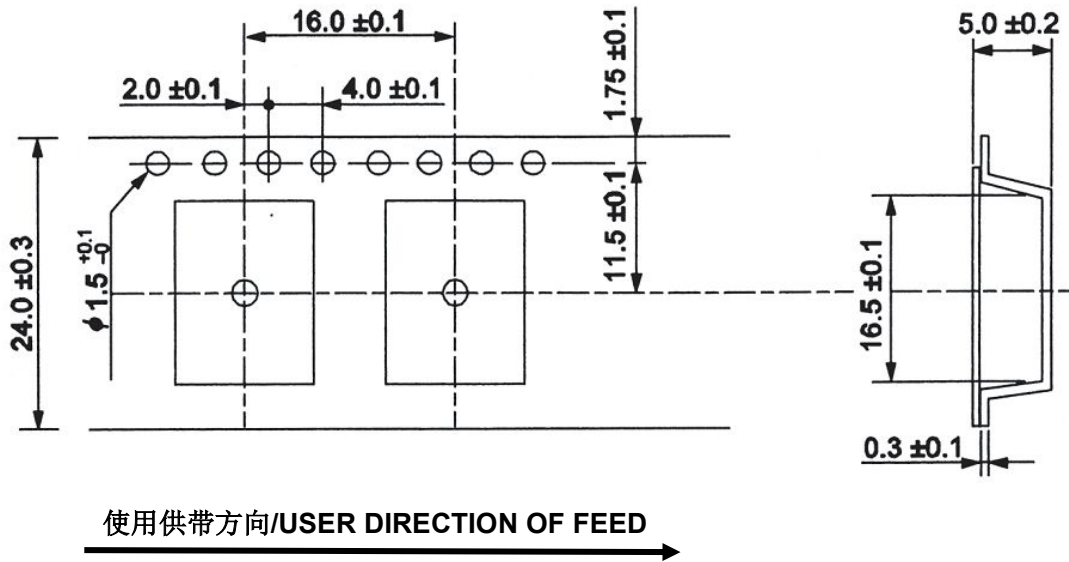
单位：毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.42		4.72	E	8.99		9.29
B	1.22		1.32	e1	2.44		2.64
b	0.76		0.86	e2	4.98		5.18
b1	1.22		1.32	L1	15.19		15.79
b2	0.33		0.43	L2	2.29		2.79
C	1.22		1.32	L3	1.30		1.75
D	9.95		10.25				



TO-263 编带规格尺寸 TO-263 TAPE AND REEL DATA

单位:毫米/UNIT: mm



编带器件定位示意图/UNIT ORIENTATION